

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司 关于购买股东中国科学院物理研究所独有以及与公司 共有部分专利的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为进一步完善公司核心知识产权保护工作，为公司今后发展提供充分保障，经与中国科学院物理研究所协商，公司拟现金出资购买中国科学院物理研究所独有以及与公司共有的碳化硅相关专利，该部分无形资产评估价值 10,218,100 元，拟定收购价格为 10,218,100 元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于购买中国科学院物理研究所独有以及与公司共有部分专利的议案》。公司董事李泓回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
中国科学院物理研究所	北京市海淀区中关村南三街8号	事业单位	方忠

(二) 关联关系

关联方名称	关联关系
中国科学院物理研究所	公司股东

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公正的原则下按市场价格进行，定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司本次拟收购的无形资产专利经北京中天衡平国际资产评估

有限公司出具的中天衡平评字[2018]11066 号评估报告，评估值为 1021.81 万元。经双方协商拟定交易价格为 1021.81 万元。交易协议在公司股东大会审议通过后签订生效。

所涉及专利清单如下表：

序号	名称	权利人	专利号	类别	申请日	授权公告日	状态
1	一种碳化硅单晶生长后的热处理方法	中国科学院物理研究所	ZL200610081294.0	发明	2006/5/29	2008/7/9	有权
2	一种用于碳化硅的欧姆电极结构的制造方法	中国科学院物理研究所	ZL200810104843.0	发明	2008/4/24	2010/10/13	有权
3	一种用于生长高质量碳化硅晶体的籽晶托	中国科学院物理研究所	ZL200810106313.X	发明	2008/5/12	2012/2/1	有权
4	一种有蜡加工晶片用粘接剂及其制备方法	苏州天科合达蓝光半导体有限公司，北京天科合达蓝光半导体有限公司，中国科学院物理研究所	ZL200910236734.9	发明	2009/11/5	2012/7/25	有权
5	研磨液、研磨液的制备方法和使用该研磨液的研磨方法	北京天科合达蓝光半导体有限公司，中国科学院物理研究所	ZL200910236733.4	发明	2009/11/5	2013/10/23	有权
6	一种籽晶处理方法和生长碳化硅单晶的方法	新疆天科合达蓝光半导体有限公司，北京天科合达蓝光半导体有限公司，中国科学院物理研究所	ZL200910236735.3	发明	2009/11/5	2013/12/18	有权
7	一种用于生长高质量导电型碳化硅晶体的方法	中国科学院物理研究所，北京天科合达蓝光半导体有限公司	ZL200910238111.5	发明	2009/11/18	2012/2/22	有权
8	一种制备高纯半绝缘碳化硅晶体的方法	中国科学院物理研究所，北京天科合达蓝光半导体有限公司	ZL200910238110.0	发明	2009/11/18	2013/9/4	有权

9	一种 SiC 单晶晶片的加工方法	北京天科合达蓝光半导体有限公司，中国科学院物理研究所	ZL200910243519.1	发明	2009/12/24	2014/1/15	有权
10	一种降低碳化硅晶体应力的退火工艺	新疆天科合达蓝光半导体有限公司，北京天科合达蓝光半导体有限公司，中国科学院物理研究所	ZL200910243520.4	发明	2009/12/24	2013/3/20	有权
11	多线切割机分段切割碳化硅晶体的方法	北京天科合达蓝光半导体有限公司，苏州天科合达蓝光半导体有限公司，中国科学院物理研究所	ZL201010179835.X	发明	2010/5/21	2013/10/23	有权
12	一种清洗碳化硅晶片表面污染物的方法	北京天科合达蓝光半导体有限公司，苏州天科合达蓝光半导体有限公司，中国科学院物理研究所	ZL201010179864.6	发明	2010/5/21	2014/5/14	有权
13	一种碳化硅晶体退火工艺	北京天科合达蓝光半导体有限公司，中科院物理研究所	ZL201010588052.7	发明	2010/12/14	2014/8/6	有权
14	高质量碳化硅表面的获得方法	北京天科合达蓝光半导体有限公司，中科院物理研究所	ZL201010588043.8	发明	2010/12/14	2014/1/15	有权
15	一种碳化硅单晶晶片表面及平整度的调整方法	北京天科合达蓝光半导体有限公司，中科院物理研究所	ZL201010588030.0	发明	2010/12/14	2014/5/21	有权
16	一种碳化硅用抛光液的制备和使用方法	苏州天科合达蓝光半导体有限公司，北京天科合达蓝光半导体有限公司，中国科学院物理研究所	ZL201010591103.1	发明	2010/12/16	2015/6/10	有权
17	半绝缘碳化硅单晶	中国科学院物理研究所	ZL201010617348.7	发明	2010/12/31	2015/5/27	有权
18	物理气相传输法生长碳化硅单晶及碳化硅单晶的原位退火工艺	北京天科合达蓝光半导体有限公司，中科院物理研究所	US9340898 B2	发明	2011/11/11	2016/5/17	有权

19	物理气相传输法生长碳化硅单晶及碳化硅单晶的原位退火工艺	北京天科合达蓝光半导体有限公司，中科院物理研究所	特许第5450895号	发明	2011/11/11	2014/1/10	有权
20	半绝缘碳化硅单晶及其生长方法	中国科学院物理研究所	特许第5657109号	发明	2011/12/6	2014/12/5	有权
21	用4H碳化硅晶体制造的非线性光学器件	中国科学院物理研究所	ZL201210004093.6	发明	2012/1/6	2016/4/27	有权
22	用4H碳化硅晶体制造的非线性光学器件	中国科学院物理研究所	US9500931B2	发明	2012/1/6	2016/1/22	有权
23	用4H碳化硅晶体制造的非线性光学器件	中国科学院物理研究所	特许第5898341号	发明	2012/1/6	2016/3/11	有权
24	一种无石墨包裹物的导电碳化硅晶体生长工艺	中国科学院物理研究所	ZL201210432144.5	发明	2012/11/2	2015/1/18	有权
25	一种碳化硅表面处理方法	中国科学院物理研究所	201410072719.6	发明	2014/2/6	2017/1/14	有权
26	一种高质量碳化硅晶体生长的方法	北京天科合达蓝光半导体有限公司，中国科学院物理研究所，新疆天科合达蓝光半导体有限公司	201410754298.5	专利申请	2014/12/10		审中-实审

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司为进一步完善公司核心知识产权保护工作，为公司今后发展提供充分保障，是合理的、必要的。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2018年12月11日